

单 N 沟道 MOSFET

ELM4N8066FDA-N

<https://www.elm-tech.com>

■概要

ELM4N8066FDA-N 是 N 沟道低输入电容，低工作电压，低导通电阻的大电流 MOSFET。

■特点

- $V_{ds}=80V$
- $I_d=60A$ ($V_{gs}=10V$)
- $R_{ds(on)} = 8.7m\Omega$ ($V_{gs}=10V$)
- $R_{ds(on)} = 12.5m\Omega$ ($V_{gs}=4.5V$)

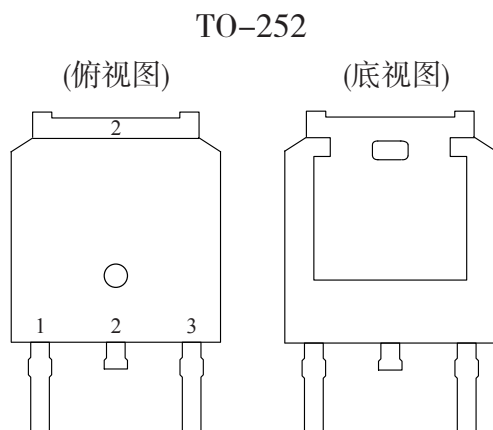
■绝对最大额定值

项目		记号	规格范围	单位	备注
漏极 - 源极电压		V_{ds}	80	V	
栅极 - 源极电压		V_{gs}	± 20	V	
漏极电流 (定常) ($V_{gs}=10V$)	$T_c=25^\circ C$	I_d	60	A	1
	$T_c=100^\circ C$		38		
脉冲漏极电流		I_{dm}	200	A	2
单脉冲崩溃能量		E_{as}	101	mJ	3
崩溃电流		I_{as}	45	A	
容许功耗	$T_c=25^\circ C$	P_d	52	W	4
保存温度范围		T_{stg}	$-55 \sim 150$	$^\circ C$	
结合部温度范围		T_j	$-55 \sim 150$	$^\circ C$	

■热特性

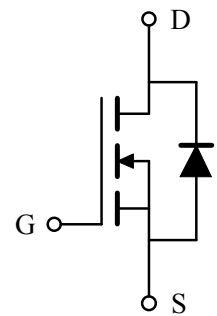
项目	记号	典型值	最大值	单位	备注
结合部 - 环境热阻	$R_{\theta ja}$	-	62.0	$^\circ C/W$	1
接合部 - 外封装热阻	$R_{\theta jc}$	-	2.4		

■引脚配置图



引脚编号	引脚名称
1	GATE
2	DRAIN
3	SOURCE

■电路图



单 N 沟道 MOSFET

ELM4N8066FDA-N

<https://www.elm-tech.com>

■电特性

如没有特别注明时, $T_j=25^{\circ}\text{C}$

项目	记号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	备注
静态特性							
漏极 - 源极击穿电压	BV_{dss}	$V_{gs}=0V, I_d=250\mu A$	80	-	-	V	
漏极 - 源极导通电阻	$R_{ds(on)}$	$V_{gs}=10V, I_d=15A$	-	6.5	8.7	$m\Omega$	2
		$V_{gs}=4.5V, I_d=15A$	-	9.0	12.5		
栅极阈值电压	$V_{gs(th)}$	$V_{gs}=V_{ds}, I_d=250\mu A$	1.20	1.55	2.3	V	
漏极 - 源极漏电流	I_{dss}	$V_{ds}=64V, V_{gs}=0V$	-	-	1	μA	
		$V_{ds}=64V, V_{gs}=0V, T_j=55^{\circ}\text{C}$	-	-	5		
栅极 - 源极漏电流	I_{gss}	$V_{gs}=\pm 20V, V_{ds}=0V$	-	-	± 100	nA	
连续源电流	I_s	$V_{gs}=V_{ds}=0V$, Force current	-	-	30	A	1, 5
二极管正向压降	V_{sd}	$V_{gs}=0V, I_s=1A$	-	-	1.2	V	2
动态特性							
输入电容	C_{iss}	$V_{ds}=40V, V_{gs}=0V, f=1\text{MHz}$	-	1738	-	pF	
输出电容	C_{oss}		-	317	-	pF	
反馈电容	C_{rss}		-	12	-	pF	
栅极电阻	R_g	$V_{ds}=0V, V_{gs}=0V, f=1\text{MHz}$	-	1.6	-	Ω	
开关特性							
总栅极电荷	Q_g	$V_{ds}=40V, V_{gs}=10V, I_d=15A$	-	29.0	-	nC	
栅极 - 源极电荷	Q_{gs}		-	7.7	-	nC	
栅极 - 漏极电荷	Q_{gd}		-	5.3	-	nC	
导通延迟时间	$t_d(on)$	$V_{dd}=40V, V_{gs}=10V$ $R_{gen}=3.3\Omega, I_d=10A$	-	6.2	-	ns	
导通上升时间	t_r		-	19.0	-	ns	
关闭延迟时间	$t_d(off)$		-	9.4	-	ns	
关闭下降时间	t_f		-	36.0	-	ns	
寄生二极管反向恢复时间	t_{rr}		-	35	-	nS	
寄生二极管反向恢复电荷	Q_{rr}	$I_f=10A, di/dt=100A/\mu s$	-	62	-	nC	

备注:

- 测试值是安装在表面为1平方英寸2盎司铜箔的 FR-4 基板的状态下取得的值;
- 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leq 300\mu s$ 和占空比 $\leq 2\%$;
- E_{as} 表示的是最大值。测试条件为 $V_{dd}=50V, V_{gs}=10V, L=0.1mH, I_{as}=45A$;
- 功耗受 150°C 结合部温度限制;
- 数据在理论上与 I_d, I_{dm} 一样, 在实际应用中受总功率损耗限制。

单 N 沟道 MOSFET

ELM4N8066FDA-N

<https://www.elm-tech.com>

■ 标准特性和热特性曲线

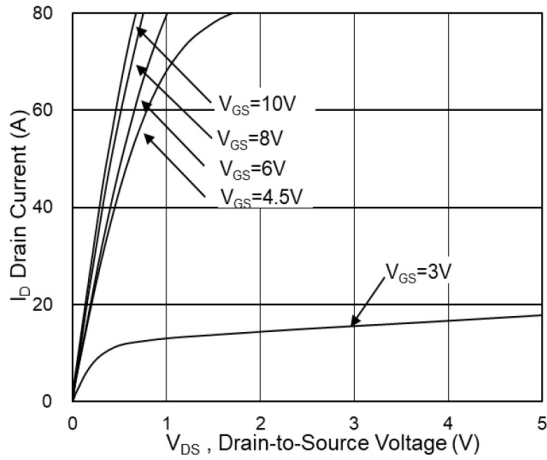


Fig.1 Typical Output Characteristics

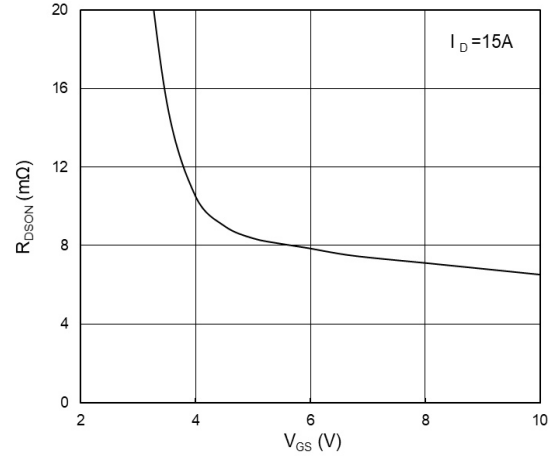


Fig.2 On-Resistance vs G-S Voltage

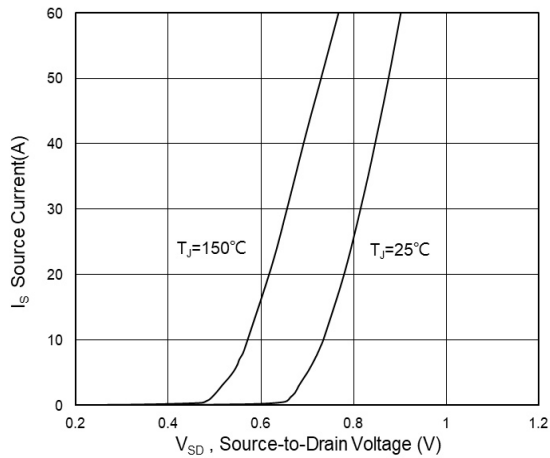


Fig.3 Source Drain Forward Characteristics

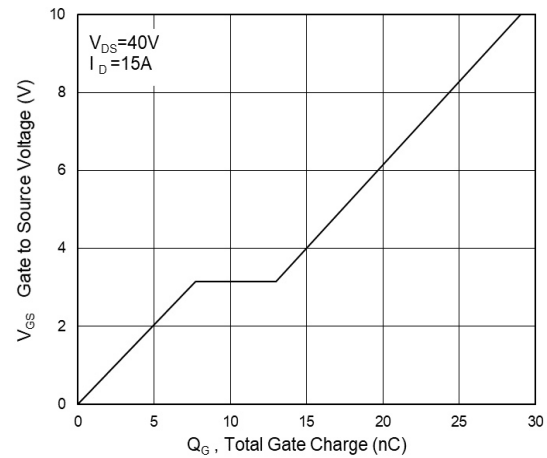


Fig.4 Gate-Charge Characteristics

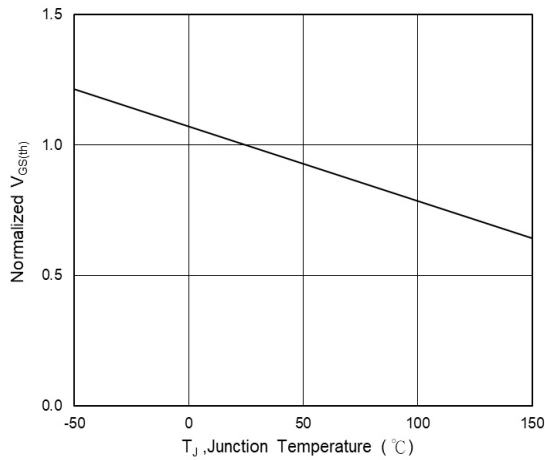


Fig.5 Normalized $V_{GS(th)}$ vs T_J

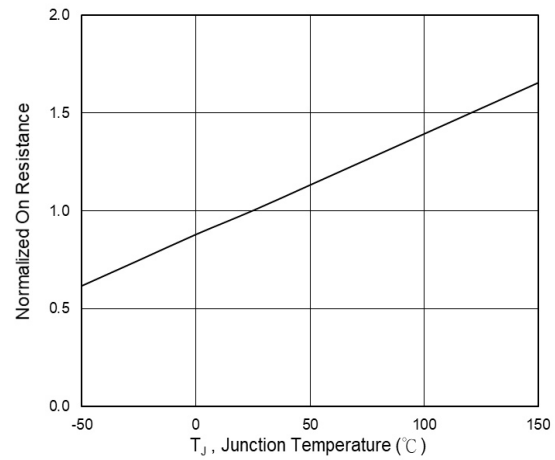


Fig.6 Normalized $R_{DS(on)}$ vs T_J

单 N 沟道 MOSFET

ELM4N8066FDA-N

<https://www.elm-tech.com>

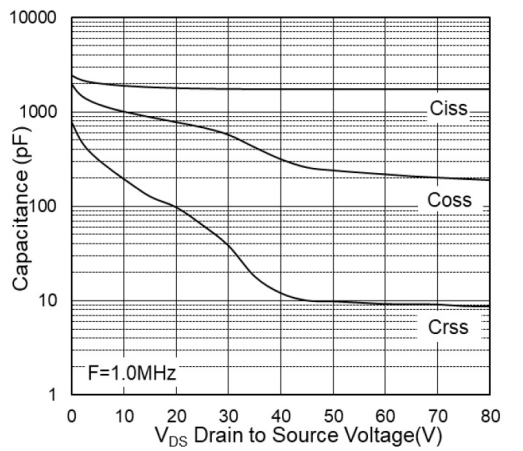


Fig.7 Capacitance

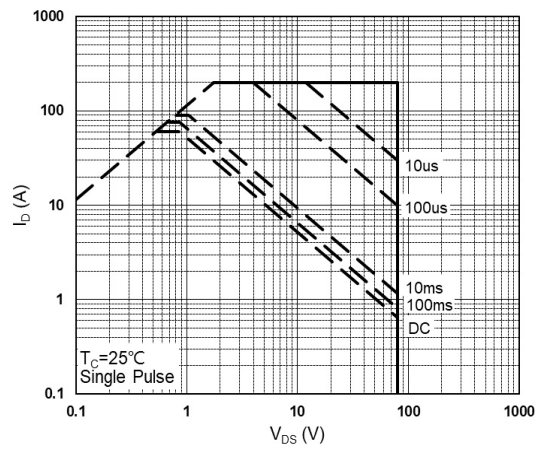


Fig.8 Safe Operating Area

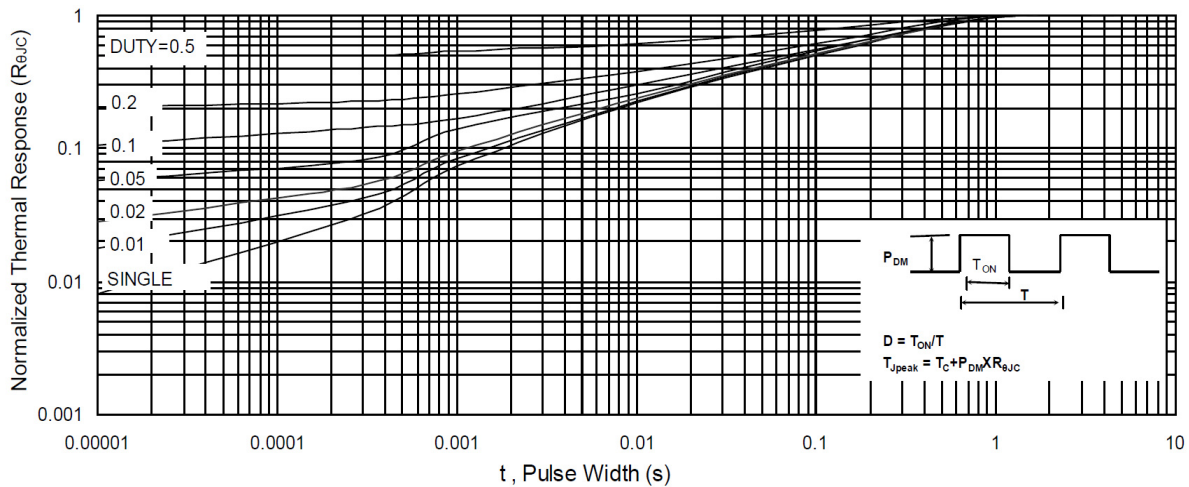


Fig.9 Normalized Maximum Transient Thermal Impedance

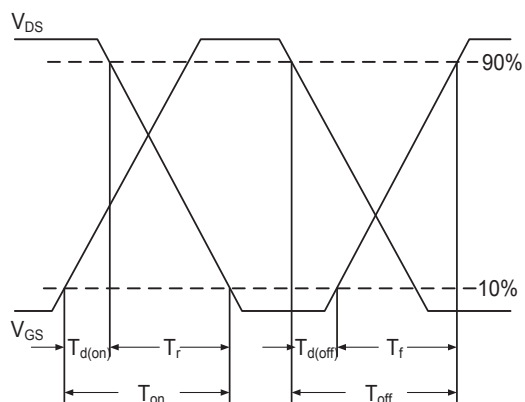


Fig.10 Switching Time Waveform

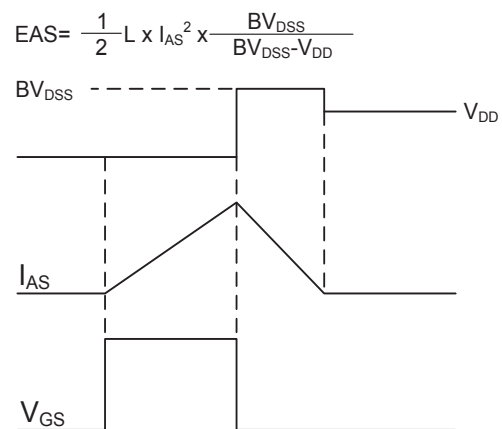


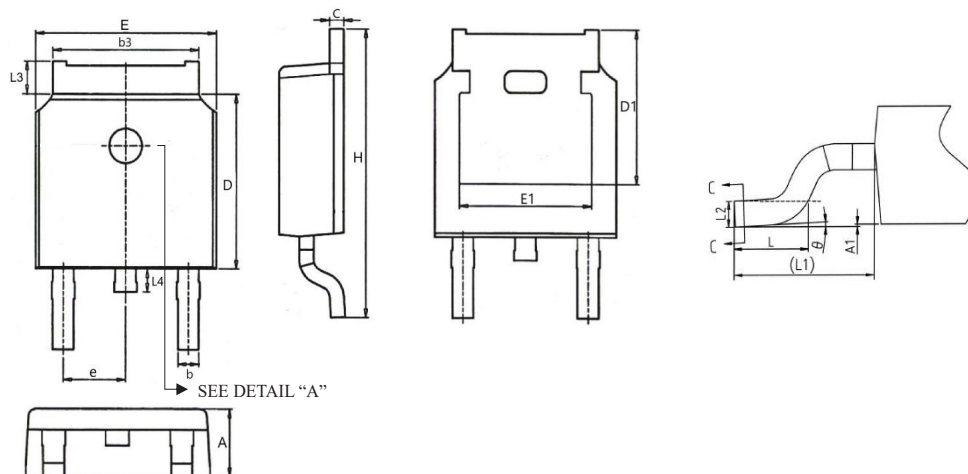
Fig.11 Unclamped Inductive Switching Waveform

单 N 沟道 MOSFET

ELM4N8066FDA-N

<https://www.elm-tech.com>

■TO-252 外形尺寸（2,500 颗 / 卷）

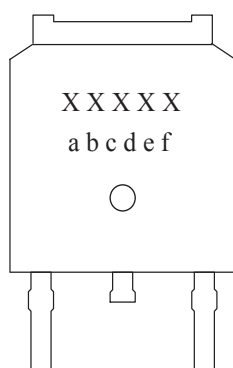


Detail "A"

	Top	Bottom		Top	Bottom
Option 1			Option 3		
Option 2			Option 4		

记号	Millimeters		Inches		记号	Millimeters		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.		Min.	Max.	Min.	Max.
A	2.18	2.40	0.086	0.094	e	2.29 BSC		0.090 BSC	
A1	0.00	0.20	0.000	0.008	H	9.40	10.50	0.370	0.413
b	0.64	0.90	0.025	0.035	L	1.27	2.03	0.050	0.080
b3	4.95	5.50	0.195	0.217	L1	2.90 REF		0.114 REF	
c	0.43	0.61	0.017	0.024	L2	0.51 BSC		0.020 BSC	
D	5.90	6.30	0.232	0.248	L3	0.88	1.28	0.035	0.050
D1	5.30 REF		0.209 REF		L4	0.50	1.02	0.020	0.040
E	6.35	6.80	0.250	0.268	θ	0°	10°	0°	10°
E1	4.32	4.95	0.170	0.195					

■封装印字说明



记号	表示内容
XXXXX	产品型号代码
a	年份代码：2019=K, 2020=L, 2021=M ...
b、c	週代码：01 ~ 53
d、e	批号：01 ~ 99 或 0A ~ 0Z
f	生产代码：A ~ Z (I、O 除外)